

シリコンPNPエピタキシャル形トランジスタ (PCT方式)  
SILICON PNP EPITAXIAL TRANSISTOR (PCT PROCESS)

# 2SA497, 2SA498

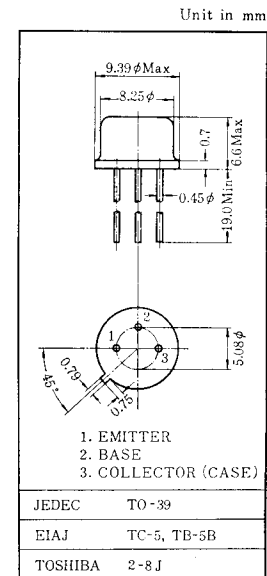
○中電力増幅用

○ Medium Power Amplifier Applications.

- 高耐圧です  $V_{CE0} = -80V$  2SA497  
 $V_{CE0} = -50V$  2SA498
- 飽和電圧が低い  $V_{CE(sat)} = -0.12V$  (Typ.)
- 2SC497, 2SC498 とコンプリメンタリになります。
- Complementary to 2SC497 and 2SC498

最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	2SA497	-80	V
	2SA498	-50	
コレクタ・エミッタ間電圧	2SA497	-80	V
	2SA498	-50	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-800	mA
エミッタ電流	$I_E$	800	mA
コレクタ損失	$P_C$	600	mW
接合温度	$T_J$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ C$



電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a = 25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = -30V, I_E = 0$	—	—	1.0	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = -5V, I_C = 0$	—	—	1.0	$\mu A$
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-80	—	—	V
			-50	—	—	
エミッタ・ベース間電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -1mA, I_C = 0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	(NOTE) $h_{FE(1)}$ $h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -2V, I_C = -200mA$	40	—	240	
		$V_{CE} = -2V, I_C = -800mA$	13	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -200mA, I_B = -20mA$	—	-0.12	-0.8	V
ベース・エミッタ間飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = -200mA, I_B = -20mA$	—	-0.9	-1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE} = -10V, I_E = 10mA$	—	70	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB} = -10V, I_E = 0, f = 1MHz$	—	33	—	pF

Note:  $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SA497 and 2SA498 are classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA497—R 2SA498—R	40	80
2SA497—O 2SA498—O	70	140
2SA497—Y 2SA498—Y	120	240